

$$\int_{V_-} \frac{\rho_-(P'_-)}{R_-} dV' = - \int_{V_+} \frac{\rho_+(P'_+) r'_-}{a R_-} dV' = - \int_{V_+} \frac{\rho_+(P'_+)}{R_+} dV',$$

что эквивалентно выполнению граничного условия $\varphi=0$. Таким образом, решение задачи имеет вид

$$\varphi(\mathbf{r}) = \int_{V_+} \frac{\rho_+(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} dV' - \int_{V_-} \left(\frac{a}{r'}\right)^5 \rho_+ \left[\left(\frac{a}{r'}\right)^2 \mathbf{r}' \right] \frac{dV'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \quad (26.18)$$

Задача 26.1. На расстоянии l от проводящей плоскости параллельно ей помещен бесконечный проводящий цилиндр радиуса a с зарядом λ на l см длины. Считая окружающую среду однородным диэлектриком с проницаемостью ϵ , найти в ней потенциал φ и силу притяжения F цилиндра к плоскости.

§ 27. СИЛЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ПРОВОДНИКИ И ДИЭЛЕКТРИКИ В ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОМ ПОЛЕ

Так как в проводниках объемная плотность электрического заряда равна нулю, то в электростатическом поле на них действует только поверхностная сила с некоторой поверхностной плотностью t . Очевидно, что сила, действующая на элемент поверхности dS , может быть представлена в виде

$$d\mathbf{F} = t dS = \eta \mathbf{E}' dS, \quad (27.1)$$

где \mathbf{E}' — напряженность *действующего поля*, равная напряженности \mathbf{E} полного поля за вычетом вклада элемента dS . Таким же методом, как в задаче 3.4, можно показать, что $\mathbf{E}' = \mathbf{E}/2$, и поэтому

$$t = \eta \mathbf{E} / 2. \quad (27.2)$$

В то же время [см. (22.6) и (22.8)]

$$\eta = \frac{1}{4\pi} (\mathbf{nD}), \quad \mathbf{E} = \mathbf{nE}. \quad (27.3)$$

Все это позволяет представить поверхностную плотность сил, действующих на проводник, в виде

$$t = \frac{1}{8\pi} (\mathbf{DE}) \mathbf{n} \equiv w_e \mathbf{n}. \quad (27.4)$$

Таким образом, проводники в электростатическом поле испытывают растяжение, очевидной причиной которого является расталкивание поверхностных зарядов. Интересно, что численно это растяжение совпадает с плотностью электростатической энергии w_e .

Перейдем теперь к вычислению сил, действующих в электростатическом поле на диэлектрическую среду. Для этого воспользуемся выведенным ранее соотношением (23.13), согласно которому изменение энергии системы при малом изменении диэлектрической проницаемости среды равно

$$\delta W_e = -\frac{1}{8\pi} \int E^2 \delta \varepsilon dV. \quad (27.5)$$

В общем случае диэлектрическая проницаемость ε является сложной функцией плотности вещества $\tau(\mathbf{r})$, температуры T , напряжений в среде и многих других параметров. Для простоты предположим, что ε зависит лишь от плотности вещества и явно от точки \mathbf{r} , т. е. $\varepsilon = \varepsilon(\mathbf{r}, \tau)$. В таком случае для вычисления сил, действующих на диэлектрик, можно воспользоваться принципом возможных перемещений и рассмотреть бесконечно малое смещение диэлектрика на вектор $\delta \mathbf{a}(\mathbf{r})$ в некоторой малой области V . Тогда

$$\begin{aligned} \delta \varepsilon &= \varepsilon[\mathbf{r} - \delta \mathbf{a}, \tau'(\mathbf{r})] - \varepsilon[\mathbf{r}, \tau(\mathbf{r})] \equiv \\ &\equiv \varepsilon[\mathbf{r} - \delta \mathbf{a}, \tau(\mathbf{r} - \delta \mathbf{a}) + \delta \tau] - \varepsilon[\mathbf{r}, \tau(\mathbf{r})] \approx \\ &\approx -(\delta \mathbf{a} \nabla \varepsilon) + \delta \tau (\partial \varepsilon / \partial \tau), \end{aligned} \quad (27.6)$$

где $\delta \tau = \tau'(\mathbf{r}) - \tau(\mathbf{r} - \delta \mathbf{a}) \approx \tau'(\mathbf{r} + \delta \mathbf{a}) - \tau(\mathbf{r})$.

Воспользуемся законом сохранения массы вещества при деформации $\mathbf{r} \rightarrow \mathbf{r}' = \mathbf{r} + \delta \mathbf{a}$, согласно которому

$$\delta(\tau dV) = \tau'(\mathbf{r}') dV' - \tau(\mathbf{r}) dV = 0. \quad (27.7)$$

Преобразуем элемент объема dV' к старым переменным, введя якобиан преобразования \mathcal{J} , т. е. полагая $dV' = \mathcal{J} dV$, где

$$\begin{aligned} \mathcal{J} &= \det \|\partial_i(x^k + \delta a^k)\| = \det \|\delta_i^k + \partial_i(\delta a^k)\| \approx \\ &\approx \prod_{i=1}^3 [1 + \partial_i(\delta a^i)] \approx 1 + \operatorname{div} \delta \mathbf{a}. \end{aligned} \quad (27.8)$$

Подставляя (27.8) в (27.7), получаем

$$\delta \tau = -\tau \operatorname{div} \delta \mathbf{a}. \quad (27.9)$$

Таким образом, из (27.6) находим

$$\delta \varepsilon = -(\delta \mathbf{a} \nabla \varepsilon) - \tau (\partial \varepsilon / \partial \tau) \operatorname{div} \delta \mathbf{a}. \quad (27.10)$$

Подставляя (27.10) в (27.5), находим изменение энергии

$$\delta W_e = \frac{1}{8\pi} \int_V E^2 \left[(\delta \mathbf{a} \nabla \varepsilon) + \tau \frac{\partial \varepsilon}{\partial \tau} \operatorname{div} \delta \mathbf{a} \right] dV. \quad (27.11)$$

С другой стороны, (27.11) должно быть пропорционально, согласно принципу возможных перемещений, элементарной

работе внешних сил. Вводя плотность сил $\mathbf{f}_e^{\text{связ}}$, действующих на диэлектрик, имеем

$$\delta W_e = - \int_V (\mathbf{f}_e^{\text{связ}} \delta \mathbf{a}) dV. \quad (27.12)$$

Для того чтобы привести δW_e к виду (27.12), выполним во втором слагаемом (27.11) интегрирование по частям. Возникающий при этом поверхностный интеграл обращается в нуль, поскольку вне области V , по условию, $\delta \mathbf{a} = 0$. Таким образом,

$$\delta W_e = \frac{1}{8\pi} \int_V \left[E^2 (\delta \mathbf{a} \nabla \varepsilon) - \delta \mathbf{a} \cdot \nabla \left(\tau \frac{\partial \varepsilon}{\partial \tau} E^2 \right) \right] dV. \quad (27.13)$$

Сравнивая (27.13) и (27.12), находим выражение для плотности сил, действующих на диэлектрик в электростатическом поле:

$$\mathbf{f}_e^{\text{связ}} = - \frac{1}{8\pi} E^2 \nabla \varepsilon + \frac{1}{8\pi} \nabla \left(\tau \frac{\partial \varepsilon}{\partial \tau} E^2 \right). \quad (27.14)$$

Задача 27.1. Показать, что при электризации тел трением или при их близком контакте положительно заряжается вещество с большей диэлектрической проницаемостью (закон Кёна).

Для разреженных диэлектриков выражение для плотности силы (27.14) упрощается. В этом случае ε можно считать линейной функцией τ , положив $\varepsilon \approx 1 + c\tau$ [см. (58.25)]. В этом приближении $\tau(\partial \varepsilon / \partial \tau) \approx \varepsilon - 1$ и (27.14) принимает вид

$$\mathbf{f}_e^{\text{связ}} = \frac{\varepsilon - 1}{8\pi} \nabla E^2. \quad (27.15)$$

Формулу (27.15) можно получить и в микроскопической теории. В самом деле, как следует из решения задачи 23.4, на диполь \mathbf{p} в электростатическом поле \mathbf{E} действует сила

$$\mathbf{F} = \nabla(\mathbf{p}\mathbf{E}) = (\mathbf{p}\nabla)\mathbf{E}. \quad (27.16)$$

Суммируя (27.16) по всем диполям \mathbf{p}_i из физического бесконечно малого объема ΔV и считая напряженность \mathbf{E}_i действующего поля совпадающей с напряженностью \mathbf{E} среднего поля в среде, что справедливо для разреженных диэлектриков с $\varepsilon - 1 \ll 1$, находим

$$\begin{aligned} \mathbf{f}_e^{\text{связ}} &= \frac{1}{\Delta V} \sum_{i \in \Delta V} \mathbf{F}_i = \frac{1}{\Delta V} \sum_{i \in \Delta V} (\mathbf{p}_i \nabla) \mathbf{E}_i \approx \\ &\approx \frac{1}{\Delta V} \sum_{i \in \Delta V} (\mathbf{p}_i \nabla) \mathbf{E} \equiv (\mathbf{P}\nabla) \mathbf{E}. \end{aligned} \quad (27.17)$$

Нетрудно видеть, что (27.17) сводится к (27.15), если учесть, что $4\pi\mathbf{P}=(\varepsilon-1)\mathbf{E}$, и использовать тождество (2П.4д), согласно которому

$$(\nabla\mathbf{V})\mathbf{E}=\nabla E^2/2-[\mathbf{E}\operatorname{rot}\mathbf{E}]=\nabla E^2/2, \quad (27.18)$$

поскольку $\operatorname{rot}\mathbf{E}=0$.

Если в диэлектрике имеются свободные заряды, распределенные с плотностью ρ , то плотность сил, действующих на среду в электростатическом поле, равна

$$\mathbf{f}_e=\rho\mathbf{E}-\frac{1}{8\pi}E^2\nabla\varepsilon+\frac{1}{8\pi}\nabla\left(E^2\tau\frac{\partial\varepsilon}{\partial\tau}\right). \quad (27.19)$$

Иногда бывает удобно, поступая так же, как при решении задачи 13.1, представить (27.19) в виде

$$\mathbf{f}_e=\operatorname{div}\hat{\mathbf{T}}_{(e)}, \quad (27.20)$$

где $\hat{\mathbf{T}}_{(e)}$ —тензор электрических натяжений, имеющий компоненты

$$T_{(e)}^{ik}=\frac{\varepsilon}{4\pi}E^iE^k-\frac{1}{8\pi}E^2\left(\varepsilon-\tau\frac{\partial\varepsilon}{\partial\tau}\right)\delta^{ik}. \quad (27.21)$$

Согласно (27.20), полная сила, действующая на диэлектрик в некоторой области V , равна

$$\mathbf{F}_e=\int_V\mathbf{f}_e dV=\int_V\operatorname{div}\hat{\mathbf{T}}_{(e)}dV. \quad (27.22)$$

Используя теорему Гаусса—Остроградского в форме (2П.6), сведем объемный интеграл в (27.22) к интегралу по поверхности S , окружающей объем V :

$$\mathbf{F}_e=\oint_S(\mathbf{n}\cdot\hat{\mathbf{T}}_{(e)})dS=\oint_S\left[\frac{\varepsilon}{4\pi}(\mathbf{n}\mathbf{E})\mathbf{E}-\frac{E^2}{8\pi}\left(\varepsilon-\tau\frac{\partial\varepsilon}{\partial\tau}\right)\mathbf{n}\right]dS. \quad (27.23)$$

§ 28. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ, СОЗДАВАЕМОЕ ЗАДАННЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ТОКОВ. ВЕКТОРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Перейдем к рассмотрению магнитостатических задач. В этом случае исходными уравнениями являются

$$\operatorname{rot}\mathbf{H}=4\pi\mathbf{j}/c, \quad \operatorname{div}\mathbf{B}=0,$$

$$\mathbf{B}=\mathbf{H}+4\pi\mathbf{M} \quad (\text{в простейшем случае } \mathbf{B}=\mu\mathbf{H}).$$

С их помощью можно определить индукцию \mathbf{B} магнитного поля, возникающего в магнетиках при наличии:

- 1) токов с заданной плотностью \mathbf{j} ;
- 2) постоянных магнитов;